

a 2021 0054

Invenția se referă la tehnologia de producere a materialelor nanostructurate, în special la procedee de obținere a nanostructurilor prin tratament electrochimic, care pot fi folosite în microelectronică, optoelectronică și nanoelectronică.

Procedeul, conform invenției, constă în fabricarea nanofirelor de GaAs sau InP prin metoda anodizării suportului semiconductor de nGaAs sau nInP în electrolit, după care suportul cu nanofirele fabricate se supune tratamentului termic la temperatura de 900°C, timp de 60 min, în atmosferă inertă de flux de Ar cu un conținut de oxigen de 3%, până la obținerea pe suportul de GaAs sau InP a nanofirelor de Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sau In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, corespunzător.

Revendicări: 1

Figuri: 5